APPARATUS AND METHOD FOR HEAT TREATMENT

Patent number:

JP10305606

Publication date:

1998-11-17

Inventor:

MATSUOKA YUKI: TSUDA FUMIKO

Applicant:

TOSHIBA CORP

Classification:

- international:

B41J2/335: H01C17/242

- european:

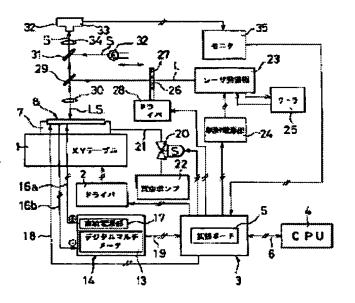
Application number:

JP19970118404 19970508

Priority number(s):

Abstract of JP10305606

PROBLEM TO BE SOLVED: To optionally control a heat treatment to an object on the basis of a change amount of a resistance value, by setting a heat treatment condition to the object in accordance with the change amount of the resistance value, and carrying out the heat treatment to the object on the basis of the set heat treatment condition. SOLUTION: A current is fed to each heatgenerating resistance body (bit). A current value is input to a CPU 4, so that a resistance value of each bit is calculated. A target resistance value Ra is input to the CPU 4 for each bit. An actually measured resistance value Rn and the target resistance value Ra set in the CPU 4 are compared with each other for each of all bits. Bits satisfying Rn>Ra are selected. An emission time (t) of a laser light calculated from a difference &Delta R of the Rn and Ra of the selected bits and position data of the bits are recorded in the CPU 4. After an XY table 1 is positioned on the basis of a pickup signal from a CCD camera 33, the laser light L is oscillated for the emission time (t) calculated from the Rn of the bits required to be adjusted and recorded in the CPU 4. After all bits are subjected to heat treatment by the laser light, the resistance value is measured again for the bite, when the heat treatment is completed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

文献4

(11)特許出願公開番号

特開平10-305606

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

識別記号

FΙ

B 4 1 J 3/20

111H

B41J 2/335 H01C 17/242

H01C 17/24

L

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 10 頁)

/21	١	ш	田米县

(22)出顧日

特願平9-118404

平成9年(1997)5月8日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 松岡 由紀

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 津田 文子

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

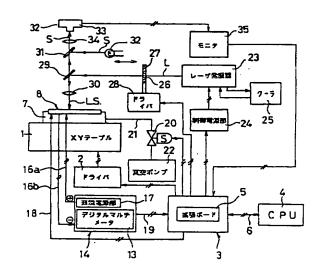
(74)代理人 弁理士 須山 佐一

(54) 【発明の名称】 熱処理装置および熱処理方法

(57)【要約】

【課題】 対象物に対して正確かつ迅速に熱処理を実行 するとともに、対象物が複数存在する場合にも、該対象 物群に対して正確かつ迅速に熱処理を実行し、各対象物 にほぼ同一の特性を付与することが可能な、経済性に優 れた熱処理装置および熱処理方法を提供すること。

【解決手段】 抵抗値の変化量に応じて対象物に対する 熱処理条件を設定し、該熱処理条件に基づいて前記対象 物に熱処理を施す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 抵抗値の変化量に応じて対象物に対する 熱処理条件を設定する手段と

前記設定した熱処理条件に基づいて前記対象物に熱処理を施す手段と、

を具備したことを特徴とする熱処理装置。

(請求項2) 前記抵抗値の変化量は、前記対象物の抵抗値の実測値と予め決められた抵抗値との差であることを特徴とする請求項1に記載の熱処理装置。

【請求項3】 前記対象物は、サーマルブリントヘッド 10 の発熱抵抗体であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の熱処理装置。

【請求項4】 前記熱処理は、レーザ光の照射であることを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載の熱処理装置。

【請求項5】 抵抗値の変化量に応じて対象物に対する 熱処理条件を設定する工程と

前記設定した熱処理条件に基づいて前記対象物に熱処理 を施す工程と、

を具備したことを特徴とする熱処理方法。

【請求項6】 前記抵抗値の変化量は、前記対象物の抵抗値の実測値と予め決められた抵抗値との差であることを特徴とする請求項5に記載の熱処理方法。

【請求項7】 前記対象物は、サーマルプリントヘッド の発熱抵抗体であることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の熱処理方法。

【請求項8】 前記熱処理は、レーザ光の照射であることを特徴とする請求項5乃至請求項7に記載の熱処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、対象物にレーザ光を照射して該対象物の抵抗値を変化させる熱処理装置および熱処理方法に関し、特に、サーマルブリントヘッドの発熱抵抗体の抵抗値のトリミングに好適な熱処理装置 および熱処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】孔版印刷機、ファクシミリ、ビデオブリンタ等に代表される各種OA機器においては、低騒音、低メンテナンスコストおよび低ランニングコスト等の利 40点があることから、サーマルブリントへッドを用いた感熱式記録方式が多用されるようになってきた。一般に、サーマルブリントへッドは、次のような構成からなっている。すなわち、図5(a)および図5(b)に示したように、サーマルブリントへッド8は、アルミナ等からなる基板9上に発熱抵抗体10a~10eを設けるとともに、該発熱抵抗体10の端部にはリード線11a~11〕を接続しており、発熱抵抗体10a~10eおよびリード線11a~11〕を接続しており、発熱抵抗体10a~10eおよびリード線11a~11〕を接続しており、発熱抵抗体10a~10eおよびリード線11a~11〕を覆うように保護膜12を配置した機成である。なお、図5(a)は、サーマルブリン 50

トヘッドを発熱抵抗体側から概観した図であり、図5 (b)は、図5 (a)のA-B線により切断した断面を 示した図である。

【0003】ところで、発熱抵抗体は、Ta-SiO, 、Nb-S iQ、Zr-SiQ、またはCr-SiQ、等の金属と SiQ、とを組 み合わせたターゲットを用いたスパッタリングにより、 200~5000オングストロームの膜厚を有する薄膜 として形成されている。通常、スパッタリングにより薄 膜として形成した発熱抵抗体をそのまま使用した場合に は、サーマルプリントヘッドの駆動時の通電によるジュ ール熱により抵抗値が低下して流れる電流が増加し、続 いて、増加した電流によりさらに発熱量が増えるためさ らに抵抗値が低下するというサイクルを繰り返すことに より、発熱抵抗体には過大な電流が流れることになる。 こうして、発熱抵抗体に過大な電流が流れると、発熱抵 抗体より所望の発熱量が得られないため、印刷した画像 の画質が劣化する。また、発熱抵抗体に過大な負荷がか かるので発熱抵抗体が破壊され、サーマルブリントヘッ ドの寿命が低下する。との発熱抵抗体の抵抗値が低下す る現象は、発熱抵抗体の分子構造が発熱により変化を起 とすためであると考えられている。そこで、 発熱抵抗体 を上述の方法で形成した場合には、発熱抵抗体の微細構 造をより安定化するために、発熱抵抗体に対して通電エ イジング、加熱炉内でのアニールまたはレーザ光の照射 によるレーザアニール等の熱処埋を施す。こうして、予 め、サーマルプリントヘッドの使用時に用いる発熱温度 より高い温度で発熱抵抗体に熱処埋を実行することによ り、発熱に起因する発熱抵抗体の抵抗値の低下を防止す ることができる。

【0004】また、通常、基板上に発熱抵抗体をスパッ タリングにより設けた場合には、発熱抵抗体の各々の間 で発熱抵抗体の抵抗値が異なっている。各々の間で抵抗 値が異なる発熱抵抗体を加熱炉によってアニールする と、発熱抵抗体の抵抗値はアニールの温度と時間とによ り制御されるにもかかわらず、各発熱抵抗体がほぼ同一 の条件で一度に処理されるので、発熱抵抗体の抵抗値の 低下を防止することができたとしても、発熱抵抗体の各 々の間における抵抗値の変動(バラツキ)は改善されな い。しかしながら、カラープリンタ等に用いるサーマル プリントヘッドにおいては、発熱抵抗体の各々の間にお ける抵抗値の変動(バラツキ)がそのまま画像の画質の 劣化に反映するため、発熱抵抗体の各々の間における抵 抗値の変動(バラツキ)の解消が必要となる。そこで、 **発熱抵抗体の各々の間における抵抗値の変動(バラツ** キ)を解消するため、発熱抵抗体にレーザ光を照射して 熱処理を行い、発熱抵抗体の各々の間における抵抗値の 変動を小さくする、換言すれば、発熱抵抗体の各々の抵 抗値を合わせることが行われる。

リード線11a~11」を覆うように保護膜12を配置 【0005】ここで、レーザ光の照射による、発熱抵抗 した構成である。なお、図5(a)は、サーマルプリン 50 体のアニール処理について説明する。 図6に示したよ

うに、アニール処理を施す以前の各発熱抵抗体(ビッ ト)の間には抵抗値の変動(バラツキ)が存在する。し たがって、アニールで必要とされる抵抗値の変化の大き さ、すなわち、抵抗値の変化量AR(アニール前の抵抗 値と目標とする抵抗値Raとの差)は発熱抵抗体のビッ ト間で異なり、アニール処理以前の発熱抵抗体の抵抗値 が大きいほど必要とする抵抗値の変化量△Rは大きい。 また、レーザ光の照射によるアニールにおいては、図7 に示したように、レーザ光の出力を一定とした場合に は、レーザ光の照射による発熱抵抗体の抵抗値の変化量 10 △Rはレーザ光の照射時間 t の関数となるため、発熱抵 抗体の抵抗値の変化量△Rを大きくするためには照射時 間 t を大きくする必要がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、発熱 抵抗体の抵抗値の変化量ARはレーザ光の照射時間tの 関数であるため、従来の熱処理装置でのレーザ光による アニールは、図8に示すように、レーザ光の照射後にお ける発熱抵抗体の抵抗値が目標とする抵抗値Raに達す るまでレーザ光の照射と抵抗値の測定とを繰り返し行 い、これを全てのビットに対して行っていた。すなわ ち、ステップ801~ステップ805を通じて第1の発 熱抵抗体に一定時間(Δ t :t1=Δ t)レーザを照射す ると抵抗値の測定を行って、抵抗体の実測値Rnと目標 とする抵抗値Raとを比較し(ステップ806)、その 結果、抵抗体の実測値Rnが目標とする抵抗値Raに違 していなければ、発熱抵抗体に2回目のレーザの照射を 一定時間 (Δt:t2=2Δt) 行って抵抗値の測定を行 い、続いて、抵抗体の実測値Rnが目標とする抵抗値R aに達していなければ、発熱抵抗体に3回目のレーザの 30 照射を一定時間(Δt:t3=3Δt)行って抵抗値の測 定を行う。一方、抵抗体の実測値Rnが目標とする抵抗 値Raに達した場合にはビット数を確認し(ステップ8 07)、全ビットに対してアニールが実施されていなけ れば次のビットにレーザの照射によるアニールを施すよ うにし(ステップ808)、全ビットに対してアニール が実施されていれば、再度、全ピットの抵抗値を測定し てアニールを終了する(ステップ809、ステップ81 0).

【0007】しかしながら、上述したように、従来の熱 処理装置によりアニールを実施すると、発熱抵抗体の抵 抗値の変化量ARが大きい発熱抵抗体ほど、レーザ光の 照射および抵抗値の測定の回数が増加するため、時に は、発熱抵抗体の1つ(1ビット)をアニールするのに 100秒程度の時間を要することもあった。

【0008】また、レーザ光の出力を一定とするととも に、レーザ光の照射時間も一定であるため、発熱抵抗体 にレーザ光の照射を繰り返している間に発熱抵抗体の抵 抗値が目標とする抵抗値Raよりも小さくなり、さら に、各ビット間での抵抗値の変動も容易に減少しないと 50 【0016】また、熱処理を施す対象物としては、セラ

いう問題があった。

【0009】本発明は、上記従来例に鑑みてなされたも ので、対象物に対して正確かつ迅速に熱処理を実行する とともに、対象物が複数存在する場合にも、該対象物群 に対して正確かつ迅速に熱処理を実行し、各対象物にほ ぼ同一の特性を付与することが可能な、経済性に優れた 熱処理装置を提供することを目的とする。

【0010】また、本発明は、対象物に対して正確かつ 迅速に熱処理を施すとともに、対象物が複数存在する場 合にも、該対象物群に対して正確かつ迅速に熱処理を施 し、各対象物にほぼ同一の特性を付与する、経済性に優 れた熱処理方法を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明に係る熱処理装置 は、抵抗値の変化量に応じて対象物に対する熱処理条件 を設定する手段と、前記設定した熱処理条件に基づいて 前記対象物に熱処理を施す手段とを具備したことを特徴 としている。

【0012】本発明に係る熱処理装置によれば、抵抗値 の変化量に応じて対象物に対する熱処理条件が設定さ れ、該設定された熱処理条件に基づいて対象物に熱処理 が施されることにより、対象物に対する熱処理を、抵抗 値の変化量を基準として任意に制御できる。したがっ て、対象物に対して正確かつ迅速に熱処理を実行できる とともに、対象物が複数存在する場合にも、該対象物群 に対して正確かつ迅速に熱処理を実行し、各対象物にほ ほ同一の特性を付与することが可能となる。

【0013】また、本発明に係る熱処理方法は、抵抗値 の変化量に応じて対象物に対する熱処理条件を設定する 工程と、前記設定した熱処理条件に基づいて前記対象物 に熱処理を施す工程とを具備したことを特徴としてい

【0014】本発明に係る熱処理方法によれば、抵抗値 の変化量に応じて対象物に対する熱処理条件を設定し、 該設定した熱処理条件に基づいて対象物に熱処理を施す ことにより、対象物に対する熱処理を、抵抗値の変化量 を基準として任意に制御できる。したがって、対象物に 対して正確かつ迅速に熱処理を施すとともに、対象物が 複数存在する場合にも、該対象物群に対して正確かつ迅 速に熱処理を施し、各対象物にほぼ同一の特性を付与す ることが可能となる。

【0015】本発明に係る熱処理装置および熱処理方法 において、抵抗値は、導体の2つの端子間に電位差Vで 電流「が流れるときに、R=V/」で表す値を意識して いるが、特に、該値に限定する必要ななく、例えば、磁 気抵抗等を意識することもできる。また、抵抗値の変化 **量は、予め決定された値でもよいし、状況に応じて適宜** 変動する値でもよい。さらに、対象物の抵抗値の実測値 と予め決められた抵抗値との差として規定してもよい。

ミック基板上にベーターTaあるいはNiCr等をスパッタリングした薄膜や銀パラジウムを焼き付けた厚膜抵抗を用いたハイブリッドICや各種の抵抗体を挙げることができ、さらに、上述したサーマルプリントヘッドの発熱抵抗体を好適に挙げることができる。

【0017】さらに、熱処理条件の設定に際しては、熱 処理条件として、熱処理の方法、熱処理を施す時間およ び熱処理の強さ等を設定する。例えば、熱処理の方法を レーザ光の照射とした場合には、レーザ光を照射する時 間および照射するレーザ光の強度等をそれぞれ動的に設 10 定することができる。また、レーザ光を照射する時間を 固定してレーザ光の強度を変動させるようにしてもよい し、レーザ光の強度を固定してレーザ光を照射する時間 を変動させてもよい。すなわち、熱処理条件の設定は抵 抗値の変化量に応じて必要とする各要素を適宜設定する ことにより実行される。また、熱処理は、上記レーザ光 の対象物への照射であってもよいし、熱源の直接的な接 触であってもよく、状況に応じて適宜選択することがで きる。なお、熱処理をレーザ光の対象物への照射とした 場合には、例えば、YAGレーザを好適に用いることが 20 できる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。

【0019】図1は、本発明に係る熱処埋装置の一実施の形態について、その構成を示した図である。

【0020】図1に示すように、該実施の形態による熱 処理装置はXYテーブルlを備えており、XYテーブル 1はドライバ2により、平面上の互いに直行するXY方 向に駆動されるようになっている。ドライバ2への駆動 30 信号は制御部3から出力され、該制御部3は、CPU4 に拡張ボード5が信号線6によって接続された構成とな っている。XYテーブル1には真空チャック7が設けら れ、サーマルブリントヘッド8は真空チャック7に吸着 保持されるようになっている。なお、サーマルプリント へっド8は、図5に示すように、アルミナ等の絶縁性の 基板9上に、多数の発熱抵抗体10a~10eが該基板 9の長手方向に沿って所定の間隔で形成されるととも に、各発熱抵抗体10a~10eの長手方向の両端部に は各々アルミニウム製のリード線11a~11jが接続 40 され、各発熱抵抗体10a~10eは保護膜12によっ て被覆された構成である。

【0021】また、サーマルプリントヘッド8の各発熱抵抗体の抵抗値は、デジタルマルチメータ13を備えた測定部14によって測定されるが、デジタルマルチメータ13とサーマルプリントヘッド8の各発熱抵抗体10a~10eとは、図2に示すように、サーマルプリントヘッド8に設けられたデバイス回路DのシフトレジスタIC15を介して一対の定電流配線16aおよび16bによって接続できるようになっている。またわち、一対

の定電流配線16aおよび16bのうち、プラス側の定 電流配線 16 a は測定部 14 に設けられた直流電源部 1 7に接続されている。シフトレジスタIC15は、拡張 ボード5と接続された駆動信号線18に接続され、駆動 信号線18には拡張ボード5を介してCPU4から駆動 信号が印加されるようになっている。シフトレジスター C15は、CPU4からの駆動信号によって1ビットず つ駆動されてONとなることで、発熱抵抗体10a~1 0 e の各々に順次電流を流す。発熱抵抗体 1 0 a ~ 1 0 eの各々に流れる電流は、他方の定電流配線 16 bを通 してデジタルマルチメータ13および拡張ボード5を介 してCPU4に入力され、CPU4で電流値から発熱抵 抗体10a~10eの各々について抵抗値が算出され る。その結果、抵抗値が目標となる抵抗値Raに違して いない発熱抵抗体(ビット)については、後述するよう に、実測した抵抗値Rnと目標となる抵抗値Raとの差 から算出した値から要求されるレーザ光の照射時間 t お よびビットの位置データがCPU4により認識される。 なお、デジタルマルチメータ13と拡張ボード5とはG

【0022】さらに、真空チャック7には中途部に電磁弁20が設けられた配管21の一部が接続されており、配管21の他端には真空ボンブ22が設けられている。また、電磁弁20は、CPU4から拡張ボード5を介して出力される駆動信号によって開閉制御されるようになっている。そして、測定部14で抵抗値が測定された結果、所定の抵抗値に達していないビットには、レーザ発振器23から発振・出力されたレーザ光しが照射されて設ビットに熱処理(アニール)が実行される。ことで、レーザ発振器23は、サーマルブリントへッド8の各発熱抵抗体を被覆した保護膜を透過する波長のレーザ光しを出力するもので、例えば、レーザの媒質としてYAG結晶が使用されたYAGレーザが用いられる。

P-IB19によって接続されている。

【0023】また、レーザ発振器23には、制御電源部24が接続されていて、制御電源部24拡張ボード5を介してCPU4からの駆動信号によつて出力が制御されるようになっている。該出力の制御は、レーザ光Lの強度を一定として、その照射時間 t を変化させることにより行われ、照射時間 t は、測定部 1 4 で実測したビットの抵抗値R n と目標とする抵抗値R a との差、すなわち、抵抗値の変化量である Δ R に応じて設定される。つまり、図3に示したように、抵抗値の変化量である Δ R は、レーザ光Lの強度を一定とした場合、照射時間 t の関数 f (t) として表せるから、予め設定した該関数 f (t) として表せるから、予め設定した該関数 f (t) により、 t 8 番目のビットに必要な抵抗値の変化量 t 8 に必要なレーザ光Lの照射時間 t 8 をCPU4 で算出し、該照射時間 t 9 の時間だけ t 8 番目のビットにレーザ光Lが照射される。

【C15を介して一対の定電流配線16aおよび16b 【0024】さらに、レーザ発振器23には、レーザ発によって接続できるようになっている。すなわち、一対 50 振器23を冷却するためのクーラ25が配管されてお

り、レーザ発振器23とクーラ25との間にはレーザ発 振器23の発熱部を冷却する冷却水が循環するようにな っている。また、レーザ発振器23から出力されるレー ザ光しの光路には、スリット26を備えた成形部材27 が設けられており、該成形部材27はドライバ28によ って駆動されるようになっている。すなわち、ビットの 寸法に応じた成形部材27の駆動により、スリット26 を通過するレーザ光しのビームの形状を設定でき、こと では、レーザ光しのビームの形状は熱処理 (アニール) するビットの寸法に一致するよう整えられることにな る。こうして、スリット26を通過したレーザ光しは、 45度の角度で配置されたダイクロイックミラー29で 下方へ反射し、対物レンズ30で集束されてXYテーブ ル1上のサーマルプリントヘッド8のビットに照射され るようになっている。また、ダイクロイックミラー29 の上方にはハーフミラー31が配置されており、該ハー フミラー31には、観察用光源32からの観察光Sが入 射する。観察光Sは、ダイクロイックミラー29を通過 してサーマルプリントヘッド8を照射し、反射光はダイ クロイックミラー29およびハーフミラー31を透過し て、撮像部32のCCDカメラ33に接眼レンズ34を 介して撮像される。CCDカメラ33からの撮像信号 は、テレビモニタ35に入力されて画像が表示されると ともに、拡張ボード5を介してCPU4に入力される。 こうして、サーマルプリントヘッドに設けられた発熱抵 抗体の各ビットのXY座標が算出される。 次に、上記 熱処理装置の動作について、図4を参照しながら説明す

【0025】はじめに、抵抗値が未調整の各発熱抵抗体 (ビット)を備えた、図5に示したようなサーマルブリ ントヘッド8をXYテーブル1の真空チャック7上に載 置し、サーマルプリントヘッド8に定電流配線I6a、 16 b および駆動信号線18を接続した後、不図示の抵 抗値測定用のキーを操作してCPU4に抵抗値の測定を 指令する(ステップ401)。ここで、各ピットの抵抗 値の測定は次のように行われる。すなわち、制御部14 に設けられた直流電源部17から、定電流配線16aお よび16bに定電流を印加するとともに、シフトレジス タIC15に駆動信号を入力してシフトレジスタIC1 5を1ビットずつ駆動して各ビットに電流が順次流され る。各ビットに流れた電流値はCPU4に入力され、該 電流値から各ビットの抵抗値を算出する(ステップ40 2)。次に、各ビットについて、目標とする抵抗値R a がCPU4に入力される(ステップ403)とともに、 全てのビットに対して実測した抵抗値RnとCPU4に 設定した目標となる抵抗値Raとを比較し(ステップ4 04~ステップ407)、抵抗値の調整が必要なビッ ト、つまり、実測した抵抗値Rnが抵抗値Raよりも高 いビットが選定される(ステップ408)。なお、目標 とする抵抗値Raは予めCPU4に入力しておくことが 50 ヘッドを20個準備し、これらを無作為に違別して2つ

でき、この場合には、ステップ403を省略することが

【0026】次いで、選定されたビットの抵抗値の実測 値と目標となる抵抗値Raとの差△Rから算出されたレ ーザ光の照射時間 t および該ビットの位置データ (k、 …n番目)がCPU4に記録されるとともに、CCDカ メラ33からの撮像信号によってXYテーブル1上のサ ーマルプリントヘッド8が撮像され、該撮像信号をもと にして、選定されたビットがレーザ光しの照射位置に位 置するよう、CPU4に記憶された位置データに基づい てXYテーブル1が位置ぎめ駆動される。例えば、k番 目のビットがレーザ光しの照射位置にくるよう、XYテ ーブル1がCCDカメラ33からの撮像信号によって位 置決めされる。また、該撮像信号によってビットの寸法 が測定されるとともに、該測定値に応じてCPU4から の駆動信号でドライバ28が駆動され、成形部材27が 光軸方向に駆動して、サーマルプリントヘッド8を照射 するレーザ光しのビームの寸法とピットの寸法とが一致 するようにする。XYテーブル1が位置決めされると、 CPU4からレーザ発振器23の制御電源部24に制御 信号が入力され、CPU4 に記録された調整を要するビ ットの抵抗値(実測値Rn)から算出された照射時間 t の時間、レーザ発振器23が作動してレーザ光しを発振 出力する。レーザ発振器23からのレーザ光しは、成形 部材27のスリット26によりビームの形状が整えられ た後、ダイクロイックミラー29に入射し、ダイクロイ ックミラー29での反射により対物レンズ30で集束さ れ、k番目の発熱抵抗体(ビット)に照射される(ステ ップ409)。このとき、XYテーブル1は、レーザ光 Lがピットの長手方向(この方向をY方向とする)に沿 って走査するようY方向に所定の速度で駆動される。次 に、例えば、k+l番目のビットがレーザ光の照射位置 に位置するよう、XYテーブル1がX方向に駆動されて 位置決めされ、k番目のビットと同様、抵抗値の調整が 行われる(ステップ409~ステップ411)。そし て、選定したビットの全てにレーザ光による熱処理を実 行すると、再度、発熱抵抗体の全てのビットに対して抵 抗値を測定した後 (ステップ412)、熱処理を終了す る(ステップ413)。なお、ステップ408におい て、実測した抵抗値Rnが抵抗値Raよりも高いビット が存在しない場合には、再度、発熱抵抗体の全てのビッ トに対して抵抗値を測定した後(ステップ412)、終 了する(ステップ413)。 【0027】次に、上記の熱処理装置を用いて、サーマ ルプリントヘッドの発熱抵抗体の抵抗値の調整を試み た。なお、サーマルプリントヘッドはビット数を460 8とし、図5に示したものと同様の構成とした。また、 発熱抵抗体の抵抗値の調整にあたっては、対照群を設定

するために、同様の条件で製造されたサーマルプリント

の群(群Aおよび群B)に分け、一方(群A)を上記の 熱処理装置により、他方(群B)を図8に示した従来通 りに熱処理を施した。その結果、群Aのサーマルプリン トヘッドは、群Bのサーマルプリントヘッドと比較し て、サーマルプリントヘッドあたりの処理時間が大幅に 短縮され、さらに、ビット間の抵抗値の変動(バラツ キ)も大きく低減することができた。

【0029】なお、本発明は、上記の一実施の形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で変形することが可能である。例えば、上述したように、レーザ光の出力の制御を、照射時間ではなくレーザ発振器に加える電力を変化させることで実行してもよいし、ビットごとに△Rを算出し、その算出結果から必要に応じてレーザ光を各ビットに照射するようにしてもよい。

[0030]

【発明の効果】以上、詳述したように、本発明に係る熱処理装置によれば、抵抗値の変化量に応じて対象物に対する熱処理条件が設定され、該設定された熱処理条件に基づいて対象物に熱処理が施されるので、対象物に対する熱処理を、抵抗値の変化量を基準として任意に制御できる。したがって、対象物に対して正確かつ迅速に熱処理を実行できるとともに、対象物が複数存在する場合にも、該対象物群に対して正確かつ迅速に熱処理を実行し、各対象物にほぼ同一の特性を付与することが可能な、経済性に優れた熱処理装置を提供することができる。

【0031】また、本発明に係る熱処理方法によれば、抵抗値の変化量に応じて対象物に対する熱処理条件を設定し、該設定した熱処理条件に基づいて対象物に熱処理を施すので、対象物に対する熱処理を、抵抗値の変化量を基準として任意に制御できる。したがって、対象物に対して正確かつ迅速に熱処理を施すとともに、対象物が

複数存在する場合にも、該対象物群に対して正確かつ迅速に熱処理を施し、各対象物にほぼ同一の特性を付与することが可能な、経済性に優れた熱処理方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る熱処埋装置の一実施の形態について、その構成を示した図である。

【図2】デジタルマルチメータ13とサーマルプリント ヘッド8の各発熱抵抗体10a~10eとの接続につい て示した図である。

【図3】レーザ光の照射による発熱抵抗体の抵抗値の変化量 ΔR とレーザ光の照射時間 t との関係を示した図である。

【図4】図1に示した熱処理装置によるアニールの工程を示したフローチャートである。

【図5】サーマルプリントへッドの構成を示した図である。

【図6】アニール処理を施す以前の各発熱抵抗体 (ビット) の間における抵抗値の変動を示した図である。

(図7) レーザ光の照射による発熱抵抗体の抵抗値の変化量ARとレーザ光の照射時間 t との関係を示した図である。

【図8】従来の熱処理装置でのレーザ光によるアニール の工程を示したフローチャートである。

【符号の説明】

1 ······ X Y テーブル 2 ······ ドライバ 3 ······ 制役 部

4……CPU 5……拡張ボード 6……信号線 7……真空チャック

30 8……サーマルブリントヘッド 9……基板 10a~10e……発熱抵抗体 11a~11j…… リード線

12……保護膜 13……デジタルマルチメータ

14……測定部 15……シフトレジスタ I C

16a、16b……定電流配線 17……直流電源部

18……駆動信号線 19……GP-IB 20… …電磁弁

2 1 ······ 配管 2 2 ······ 真空ポンプ 2 3 ······ レー ザ発振器

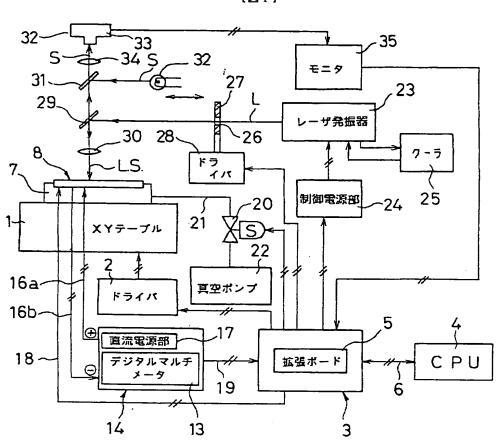
40 24……制御電源部 25……クーラ 26……ス リット

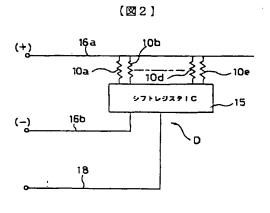
27……成形部材 28……ドライバ 29……ダ イクロイックミラー

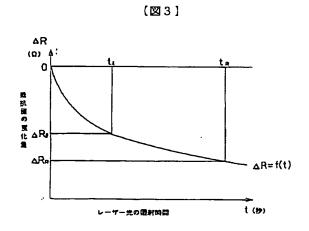
30……対物レンズ 31……ハーフミラー 32

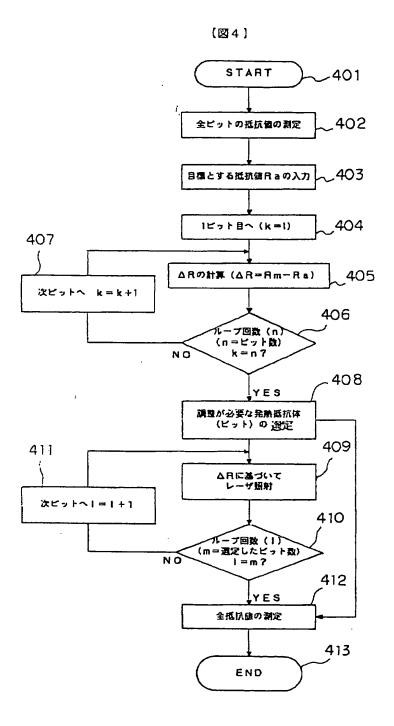
……撮像部 33……CCDカメラ 34……接眼レンズ 35 ……テレビモニタ

(図1)

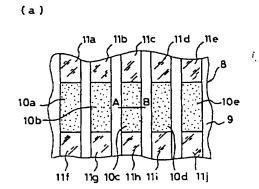




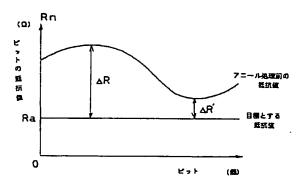




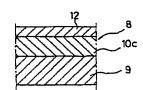
【図5】



[図6]



(b)



[図7]

